

2SA606, 607/2SC959, 960

PNP/NPN エピタキシャル形シリコントランジスタ/

PNP/NPN SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR

低周波増幅用/Audio Frequency Amplifier

特徴/FEATURES

- ・実効出力30~50Wのステレオアンプのドライバとして最適。
Suitable for Driver of 30 to 50 watts Audio Amplifiers.
- ・電流増幅率の電流に対するリアリティがよい。
Excellent Current gain linearity.

絶対最大定格/ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

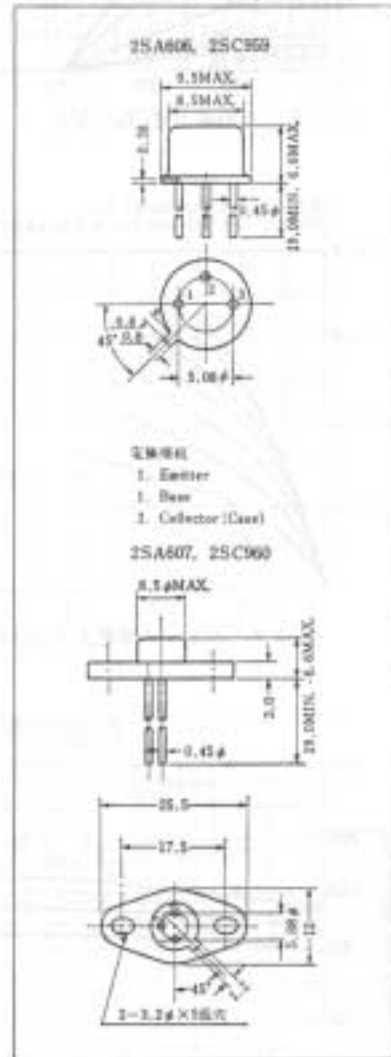
項目	略号	2SA606	2SA607	2SC959	2SC960	単位
コレクタ・ベース間電圧	V_{CB0}	-100	-100	120	120	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CE0}	-80	-80	80	80	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EB0}	-5.0	-5.0	5.0	5.0	V
コレクタ電流(直流)	$I_{C(DC)}$	-0.7	-0.7	0.7	0.7	A
コレクタ電流(パルス)	$I_{C(pulse)}$ *	-1.2	-1.2	1.2	1.2	A
全損失	$P_T(T_C=25^\circ\text{C})$	0.7	1.0	0.7	1.0	W
ジャンクション温度	T_j		150			$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}		-65~+150			$^\circ\text{C}$

* $PW \leq 10\text{ms}$, duty cycle $\leq 50\%$ 電気的特性/ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	$V_{CB} = 80\text{V}$, $I_E = 0$			3.0	μA
エミッタシャ断電流	I_{EBO}	$V_{EB} = 5.5\text{V}$, $I_C = 0$			3.0	μA
直流電流増幅率	h_{FE1}	$V_{CE} = 5.0\text{V}$ $I_C = 10\text{mA}$ *	20			
	h_{FE2}	$V_{CE} = 5.0\text{V}$ $I_C = 200\text{mA}$ *	40	80	200	
コレクタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = 500\text{mA}$ $I_E = 50\text{mA}$ *			2.0	V
利得帯域幅積	f_T	$V_{CE} = 10\text{V}$ $I_C = 100\text{mA}$	50			MHz
コレクタ容量	C_{ob}	$V_{CB} = 10\text{V}$, $I_E = 0$			50	pF

* パルス測定 $PW \leq 350\mu\text{s}$ duty cycle $\leq 2\%$ /pulsed h_{FE} 区分/ h_{FE} classification h_{FE2} /N: 40~80 M: 60~110 L: 90~150 K: 130~200

外形図/PACKAGE DIMENSIONS (Unit:mm)



This datasheet has been downloaded from:

www.DatasheetCatalog.com

Datasheets for electronic components.